

关键指标

频率：1~7GHz
 插入损耗：0.9dB
 隔离度：40dB
 电压/电流：+5V/1mA
 控制电平：0/+5V
 芯片尺寸：1.35mm×1.05mm×0.1mm

产品简介

HG123K-2 是一款 1~7GHz 反射式单刀双掷开关芯片，插入损耗为 0.9dB，隔离度为 40dB。集成控制驱动器，+5V 单电源供电，控制电平 0/+5V。

电性能 (T_A=25°C, V_{dd}=+5V)

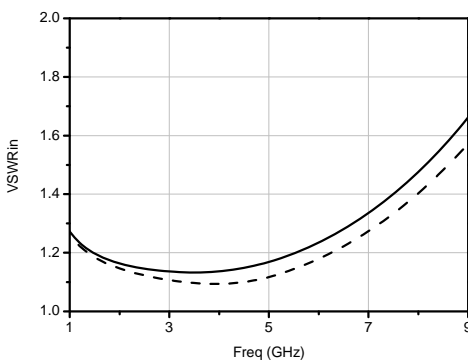
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	1~7		
输入驻波	-	1.3	-
输出驻波	-	1.4	-
插入损耗(dB)	-	0.9	-
隔离度(dB)	-	40	-
静态电流 (mA)	-	1	-

真值表

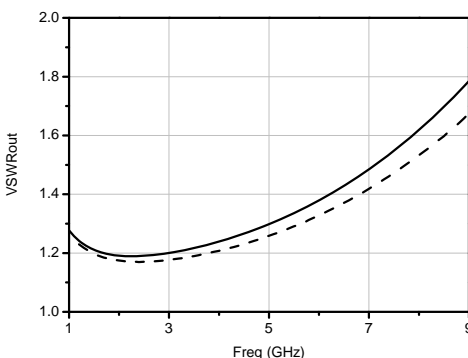
SW	RFC-RF1	RFC-RF2
+5V	OFF	ON
0V	ON	OFF

典型测试曲线

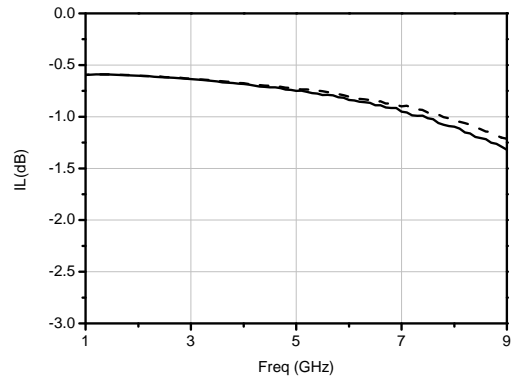
输入驻波



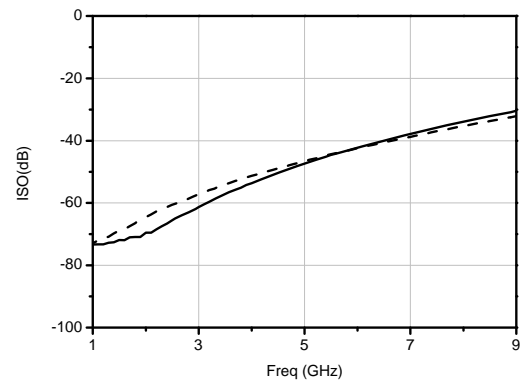
输出驻波



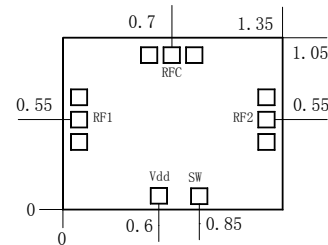
插入损耗



隔离度



外形和端口尺寸 (mm)



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm	
工作电压	+5.5V	
控制电平	低电平：0~0.5V	高电平：3.5~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。